

**Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziția  
00384 / 03.07.2017  
și pentru admitere la publicare în volum tipărit**

care se bazează pe:

**A. Nota de constatare și confirmare a indicilor de plagiat prin fișa suspiciunii inclusă în decizie.**

<b>Fișa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism's suspicion</b>		
	<b>Opera suspicionată (OS)</b>	<b>Opera autentică (OA)</b>
	<b>Suspicious work</b>	<b>Authentic work</b>
OS	Ioachim Andrei, Toacsan Mariana Irina, Nedelcu Liviu, Banciu Marin Gabriel, Duțu Constantin Augustin, Andronescu Ecaterina, Jinga Sorin. Thermal Treatments Effects on Microwave Dielectric Properties of Ba (Zn1/3Ta2/3) O3 Ceramics. <i>Romanian Journal of Information Science and Technology</i> . 2007 Jan 1;10:261-268.	
<b>Note:</b> a) the source of suspicion: <a href="http://www.integru.org">www.integru.org</a> . b) This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEEX No. 4 / 2005.		
OA	Ioachim A, Toacșan MI, Banciu M.G, Nedelcu L, Duțu CA, Feder M, Plăpcianu C, Lifei F, and Niță P. Effect of the sintering temperature on the Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O 3 dielectric properties. <i>Journal of the European Ceramic Society</i> . 2007 Dec 31;27(2):1117-1122. (Available on-line in 12 June 2006).	
Note: This work was supported by Ministry of Education and Research under contract nr: 09N/505.2003.		
<b>Incidența minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion</b>		
p.262:14 – p.262:37		p.1117:10d – p.1118:23s
p.262:39 – p.263:07		p.1118:26s – p.1118:35s
p.263:Fig.1		p.1118: Table 1
p.264:Fig.2		p.1118:Fig.1
p.265:Fig.3		p.1120: Fig.3
p.265:01 – p.266:05		p.1120:21d – p.1120:47d
p.266:Fig.5		p.1121:Fig.7
p.266:Fig.6		p.1121:Fig.9
p.267:08 – p.267:20		p.1121:06d – p.1122:05d
Fișa întocmită pentru includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România de la Sheet drawn up for including the suspicion in the Index of Plagiarized Works in Romania at <a href="http://www.plagiate.ro">www.plagiate.ro</a>		

**Notă:** Prin „p.72:00” se înțelege paragraful care se termină la finele pag.72. Notația „p.00:00” semnifică până la ultima pagină a capitolului curent, în întregime de la punctul initial al preluării.

**Note:** By „p.72:00” one understands the text ending with the end of the page 72. By „p.00:00” one understands the taking over from the initial point till the last page of the current chapter, entirely.

**B. Fișa de argumentare a calificării de plagiat alăturată, fișă care la rândul său este parte a deciziei.**

Echipa Indexului Operelor Plagiate în România

## Fișă de argumentare a calificării

Nr. crt.	Descrierea situației care este încadrată drept plagiat	Se confirmă
1.	Preluarea identică a unor pasaje (piese de creație de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
2.	Preluarea a unor pasaje (piese de creație de tip text) rezumate dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
3.	Preluarea a unor pasaje (piese de creație de tip text) dintr-o operă autentică publicată anterior, prin parafrasare, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
4.	Preluarea identică a unor figuri (piese de creație de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
5.	Preluarea identică a unor tabele (piese de creație de tip structură de informație) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
6.	Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuție explicită în lista de autori	✓
7.	Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista inițială de autori.	
8.	Preluarea identică de pasaje (piese de creație) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței, fără nici o intervenție personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
9.	Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creație de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
10.	Preluarea identică de tabele (piese de creație de tip structură de informație) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
11.	Preluarea identică a unor fragmente de demonstrație sau de deducere a unor relații matematice care nu se justifică în regăsirea unei relații matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și înșușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
12.	Preluarea identică a textului (piese de creație de tip text) unei lucrări publicate anterior sau simultan, cu același titlu sau cu titlu similar, de un același autor / un același grup de autori în publicații sau edituri diferite.	
13.	Preluarea identică de pasaje (piese de creație de tip text) ale unui cuvânt înainte sau ale unei prefete care se referă la două opere, diferite, publicate în două momente diferite de timp.	

**Notă:**

a) Prin „proveniență” se înțelege informația din care se pot identifica cel puțin numele autorului / autorilor, titlul operei, anul apariției.

b) Plagiul este definit prin textul legii<sup>1</sup>.

„...plagiul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la operele originale...”.

Tehnic, plagiul are la bază conceptul de **piesă de creație** care<sup>2</sup>:

„...este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o construcție logică și de argumentare care presupune niște premise, un raționament și o concluzie. Piesa de creație presupune în mod necesar o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creație se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a acesteia...”

cu care se poate face identificarea operei plagiate sau suspionate de plagiul<sup>3</sup>:

„...O operă de creație se găsește în poziția de opera plagiată sau opera suspionată de plagiul în raport cu o altă operă considerată autentică dacă:

- i) Cele două opere tratează același subiect sau subiecte înrudite.
- ii) Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspionate.
- iii) Cele două opere conțin piese de creație identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect și o formă de prezentare bine definită.
- iv) Pentru piesele de creație comune, adică prezente în opera autentică și în opera suspionată, nu există o menționare explicită a provenienței. Menționarea provenienței se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creație preluate din opera autentică.
- v) Simpla menționare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluiară nu este de natură să evite punerea în discuție a suspiciunii de plagiul.
- vi) Piese de creație preluate din opera autentică se utilizează la construcții realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de autorul operei suspionate prin poziția sa explicită.
- vii) În opera suspionată se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare și tratare care leagă aceleași premise cu aceleași concluzii ca în opera autentică...”

<sup>1</sup> Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004

<sup>2</sup> ISOC, D. *Ghid de acțiune împotriva plagiului: bună-conducță, prevenire, combatere*. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.

<sup>3</sup> ISOC, D. *Prevenitor de plagiul*. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.

Different title and authorship than the other 3 papers.

E. Andronescu and S. Jinga were added after the ECERS paper, although there is virtually no new content.

ROMANIAN JOURNAL OF INFORMATION  
SCIENCE AND TECHNOLOGY  
Volume 10, Number 3, 2007, 261–268

## Thermal Treatments Effects on Microwave Dielectric Properties of $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$ Ceramics

A. IOACHIM<sup>1</sup>, M. I. TOACSĂN<sup>1</sup>, L. NEDELCU<sup>1</sup>, M. G. BANCIU<sup>1</sup>,  
C. A. DUTU<sup>1</sup>, E. ANDRONESCU<sup>2</sup>, S. JINGA<sup>2</sup>

<sup>1</sup>National Institute of Materials Physics, Bucharest-Măgurele, România

E-mail: ioachim@infim.ro

<sup>2</sup>“Politehnica” University of Bucharest, România

E-mail: s.jinga@oxy.pub.ro

EDX is missing, although EDX analysis is performed (see page 3), the same as in the Elsevier version, which mentions EDX in the abstract.

**Abstract.**  $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$  dielectric materials were prepared by solid state reaction. The samples were sintered at temperatures in the range 1 400  $\div$  1 600°C for 4 h. Morphostructural characterization was performed by using SEM and XRD. The dielectric properties were measured in the microwave range (6  $\div$  7 GHz). An additional annealing at 1 400°C for 10 hours was performed in order to improve the dielectric parameters. The best parameters were achieved for the samples sintered at 1 600°C with additional thermal treatment.

### 1. Introduction

Same type as in the IEEE paper.

$\text{Ba}(\text{B}'_{1/3}\text{B}''_{2/3})\text{O}_3$  complex perovskites are very attractive materials for very high frequency applications due to owing to their attractive properties, especially the ultra high values of the quality factor  $Q$ .  $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$  compound (BZT) has potential for applications in satellite broadcasting at frequencies higher than 10 GHz and as a very high  $Q$  dielectric resonators (DR) in mobile phone base stations or combiner filter for PCS applications [1]. The BZT ceramics exhibit a dielectric constant of 29, a  $Q \times f$  product of 100 000  $\div$  160 000 GHz and a low temperature coefficient of resonant frequency  $\tau_f$  close to zero in the presence of such additives as strontium-gallium [2]. There are several factors, which influence the  $Q$  values of perovskites  $\text{Ba}(\text{M}_{1/3}^{2+}\text{Ta}_{2/3}^{5+})\text{O}_3$  with  $\text{M} = \text{Mg}, \text{Zn}$  such as: the long range ordering (LRO) of cations, the

zinc oxide evaporation, the point defects and the stabilization of the microdomain boundaries [2]. The high Q values were explained from the point of view of the lattice vibrations of its trigonal superstructure. Sagala *et al.* calculated the dielectric loss tangent in microwaves from the equation of ion motions, which was a function of B-site ordering [3]. Galasso and co-workers concluded that the B-site ordering increased as the difference in charge and size between B' and B'' atoms increased [4]. The ordering of complex perovskite BZT is important because the 1:2 ordering of the B' and B'' cations along the  $\langle 111 \rangle$  axis is believed to be closely related to the high-Q property of BZT. There is a strong correlation between the cation ordering degree, domain growth, zinc loss and sintering parameters. The synthesis of a BZT material, its structural and morphologic characteristics as well as its microwave dielectric properties correlated to the thermal treatments parameters are reported.

## 2. Methods

$\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$  samples were prepared by solid-state reaction. The starting materials were  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{ZnO}$  and  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ . Stoichiometric quantities were weighted, ground, homogenized and milled in an agate mill in water for two hours. The powders were calcined at  $T = 925^\circ\text{C}$  for two hours. Then the powders were milled for 2 h and calcined at  $1\ 000^\circ\text{C}/2\text{ h}$ . The third calcination was carried out at  $T = 1\ 150^\circ\text{C}/2.5\text{ h}$ , in air. The triple calcined powders were mixed with 1% polyvinyl alcohol (PVA) and dried at  $T = 80^\circ\text{C}$ , then were pressed into cylindrical samples of 12 mm diameter and 10 mm height. The pellets were slowly dried at  $80^\circ\text{C}$  in order to eliminate the PVA.

The density of green ceramics was  $\rho = 4\ 400\ \text{kg/m}^3$ . The sintering treatment for the BZT samples was performed in air for 4 h at five different temperatures:  $1\ 400^\circ\text{C}$ ,  $1\ 450^\circ\text{C}$ ,  $1\ 500^\circ\text{C}$ ,  $1\ 525^\circ\text{C}$  and  $1\ 600^\circ\text{C}$ . In order to improve the dielectric properties, especially the quality factor  $Q$ , the samples were treated supplementary for 10 h at  $1\ 400^\circ\text{C}$ . The pellets were polished in order to remove the superficial zone and to obtain correct values of the microwave dielectric parameters.

The relative bulk density of sintered disks was measured by the Archimedes method. Morphological, structural and compositional analyses were performed on 5 sets of samples by X-ray diffraction (XRD) analysis, and electron microscopy (SEM, EDX). The patterns were recorded in a  $2\theta$  range from  $20^\circ$  and  $90^\circ$  on a Seifert Debye Flex 2002 diffractometer into the  $2\theta - \theta$  mode. Measurements were performed at room temperature using  $\text{Cu K}_\alpha$  radiation, Ni filter and a detector scan speed of  $7^\circ/\text{min}$ .

The dielectric parameters, i.e. the dielectric constant  $\varepsilon_r$ , the quality factor  $Q$  and the loss tangent  $\tan \delta$  were measured in the microwave range by Hakki-Coleman method. A computer aided measurement system containing a HP 8757 C scalar network analyzer and a HP 8350 B sweep oscillator was employed.

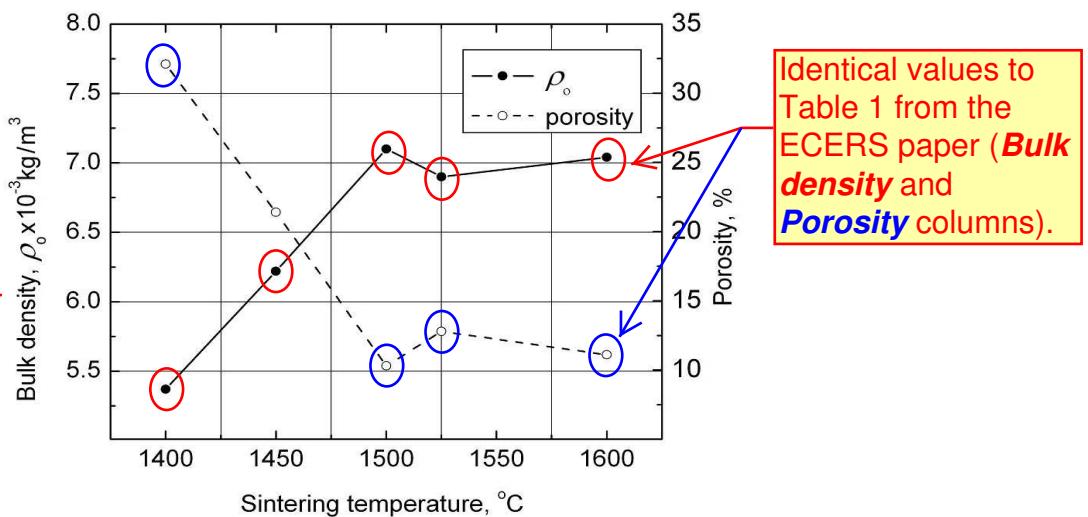
## 3. Results

The bulk density of the fired BZT ceramics was measured after grinding and polishing. The temperature dependence of densification after 4 h sintering in air

In the TSF and ECERS articles, this result is cited from different authors, namely [6] Roulland et al. That citation is missing here, and those authors do not appear in the reference list in this article.

is shown in Fig. 1. BZT ceramics sintered between  $1500^\circ\text{C}$  and  $1600^\circ\text{C}$  were well sintered.

The X-ray density of  $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$  ceramic is  $\rho_t = 7920 \text{ Kg/m}^3$ . The most dense ceramics exhibit a porosity value of 10%. An abnormal grain growth together with an accentuated ZnO evaporation occurred above the sintering temperature  $T_s = 1525^\circ\text{C}$ , so the bulk density slightly decreased. Above  $T_s = 1525^\circ\text{C}$ , the bulk density continued to increase.



**Fig. 1.** Bulk density versus sintering temperature for BZT samples.

The X-ray diffraction patterns for BZT ceramic samples sintered at five sintering temperatures are given in Fig. 2. The patterns confirm the formation of the hexagonal structure, which is the majority phase. For the BZT compounds sintered at  $T_s = 1525^\circ\text{C}$  the patterns reveal the presence of secondary phases  $\text{Ba}_7\text{Ta}_6\text{O}_{22}$ ,  $\text{Ba}_8\text{ZnTa}_{24}$  and  $\text{BaO}$ , which disappear at higher sintering temperatures. The superlattice peaks at  $2\theta = 17.6$  and  $26.4$  degrees increase in intensity with the increase of  $T_s$  up to  $1525^\circ\text{C}$ . At  $T_s = 1600^\circ\text{C}$  they practically disappear. For temperatures up to  $1525^\circ\text{C}$ , the LRO gradually increases with the temperature increase.

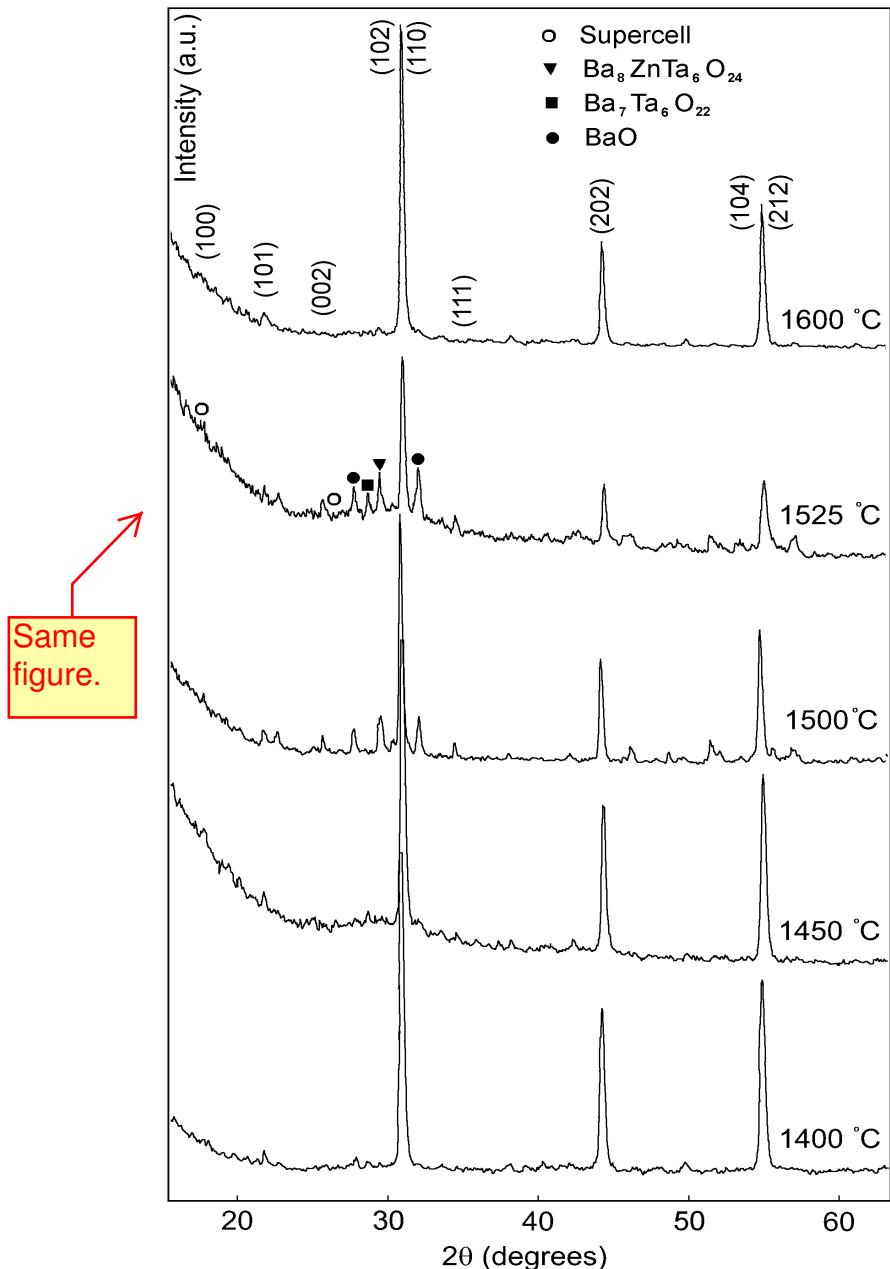
The microstructure of BZT ceramics sintered in air at  $1500^\circ\text{C}/4\text{h}$  and  $1600^\circ\text{C}/4\text{h}$  was investigated by using SEM. The images are presented in Figs. 3–4. The micrograph presents a bimodal distribution of the grains size for BZT sample sintered at  $1500^\circ\text{C}$ . Micron grains are located on the grain boundaries or on the grain surfaces; some grains with size in the range  $3 \div 6 \mu\text{m}$  are polyhedral with rounded corners and not well faceted and others are spherical with sizes up to  $1.5 \mu\text{m}$ . Well faceted, polyhedral grains with smooth surfaces and edges and dimensions in the range  $(10 \div 30) \mu\text{m}$  are observed for BZT sample sintered at  $1600^\circ\text{C}$ . The abnormal granular growth together with the ZnO evaporation can explain the non-monotonic variation of the BZT bulk density with  $T_s$ , for  $T_s > 1500^\circ\text{C}$ . The relatively small difference between

Same graph as IEEE and TSF. The ECERS paper has a table with the same values.

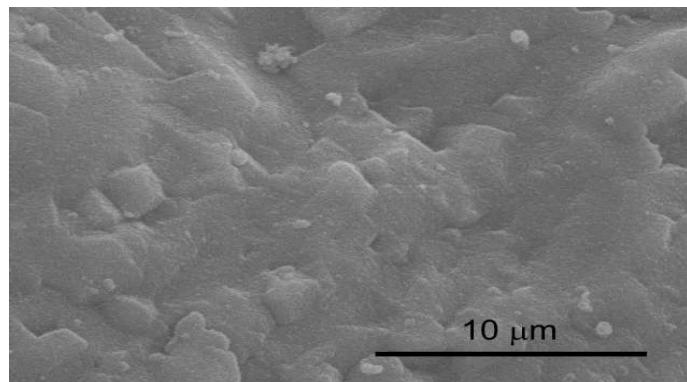
Identical values to Table 1 from the ECERS paper (**Bulk density** and **Porosity** columns).

Different numerical value from the IEEE paper, although all other results, pictures and graphs are identical.

1 500°C and 1 600°C sintering temperatures has as effect a strong granular growth, as can be noticed in Fig. 3 and Fig. 4.

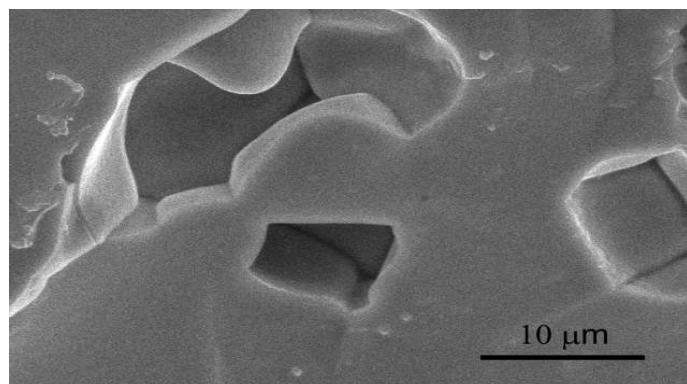


**Fig. 2.** XRD patterns of  $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$  system versus sintering temperature.



Same  
picture to  
TSF and  
IEEE.

Fig. 3. Micrographs of the BZT sample sintered 1 500°C/4 h.

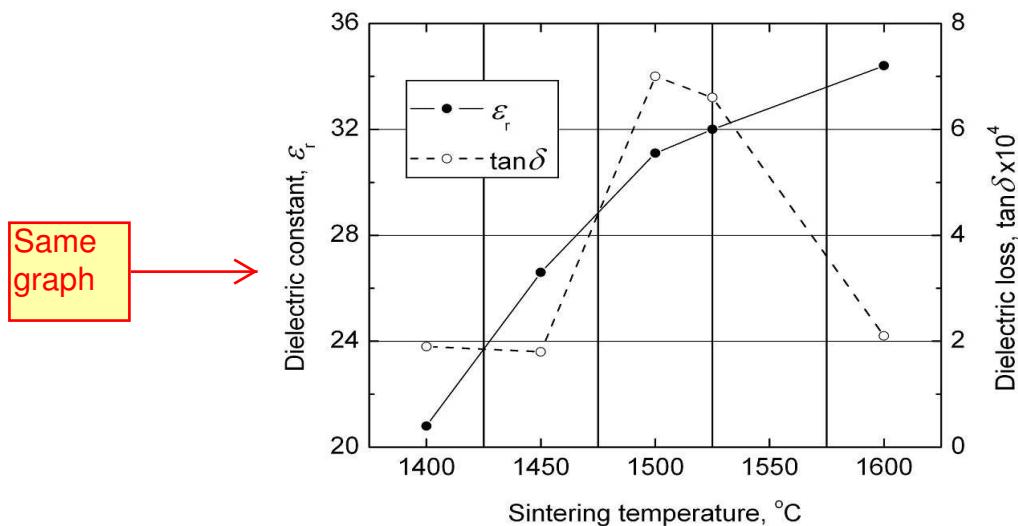


Same  
picture to  
TSF and  
IEEE.

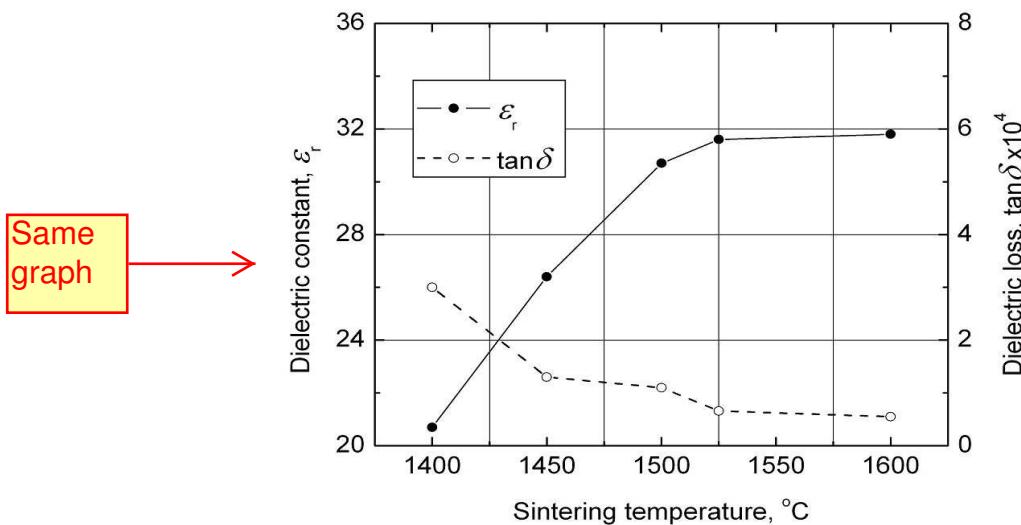
Fig. 4. Micrographs of the BZT sample sintered 1 600°C/4 h.

Microwave measurements on dielectric constant and loss tangent were carried out on the BZT samples. The obtained data revealed a determinant influence of the sintering temperature on the complex dielectric constant. The variation of the dielectric constant and dielectric loss with the sintering temperature can be observed in Fig. 5. This can be considered as an effect of the reduced porosity resulting in a better densification at high sintering temperatures, as can be seen in Fig. 1.

The loss tangent exhibits values around  $2 \times 10^{-4}$  for samples sintered at 1 400°C and 1 450°C. With the sintering temperature increase, the dielectric loss tangent increases up to  $7 \times 10^{-4}$  for  $T_s = 1 500^\circ\text{C}$ , then decreases down to  $2 \times 10^{-4}$  for  $T_s = 1 600^\circ\text{C}$ , as can be noticed in Fig. 5. This variation could be related to the Zn and Ta cation ordering process and with the secondary phases, which appear for sintering temperatures between 1 450°C and 1 525°C as shown in Fig. 2. For temperatures higher than 1 525°C, these phases disappear and, consequently, the dielectric loss decreases.



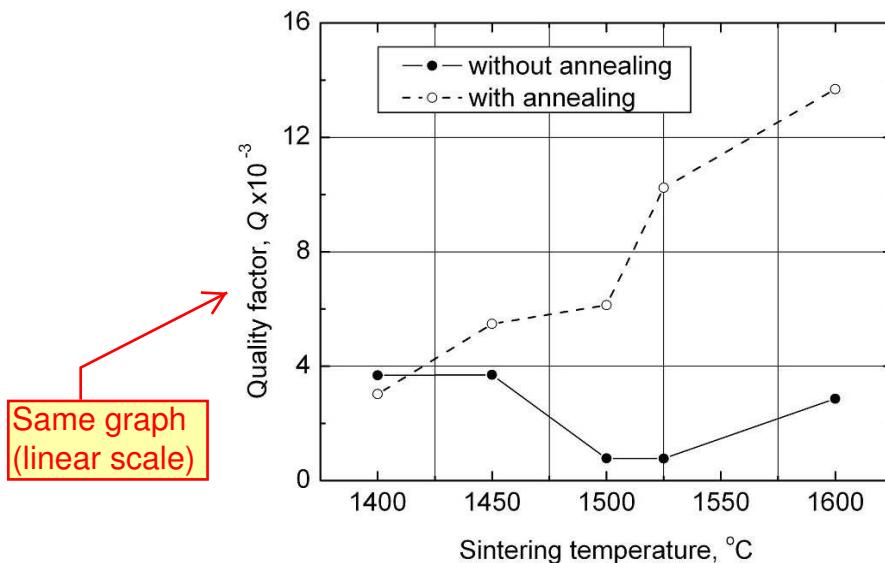
**Fig. 5.** Dielectric properties versus sintering temperature for BZT samples without annealing.



**Fig. 6.** Dielectric properties versus sintering temperature for annealed BZT samples.

The additional thermal treatment at 1400°C for 10 h for all the samples resulted in the reduction of the BZT dielectric loss as can be seen in Fig. 6. For annealed samples, the dielectric loss continuously decreases with the increase of the sintering temperature. The dielectric constant values were not substantially modified by the annealing treatment, with only one exception of the BZT samples sintered at 1600°C.

The quality factor  $Q$  values normalized at 10 GHz for the BZT samples are presented in Fig. 7. The  $Q$  is higher for annealed samples than for the samples without thermal treatment; this difference is more significant especially for BZT samples sintered beyond 1 525°C, which indicate the necessity of post sintering thermal treatment. The BZT samples sintered at 1 600°C exhibit a dielectric constant of about 31 and a quality factor normalized to 10 GHz up to 13 500.



**Fig. 7.** Quality factor normalized at 10 GHz versus sintering temperature for BZT samples with and without annealing.

#### 4. Conclusions

TSF and IEEE papers read "higher than".

$\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$  ceramics with low loss in microwave domain were obtained by solid state reaction in the temperature range 1 400  $\div$  1 600°C.

For sintering temperatures higher than 1 500°C, the XRD patterns reveal the BZT multiphase compositions with the presence of trigonal supercell peaks and low Zn content secondary phases. The last two disappear for samples sintered at 1 600°C.

The quality factor  $Q$  strongly depends on the BZT crystalline structure: the unit cell distortion and cationic order. Dielectric loss decreases with the increase of ordering degree in the structure and with the disappearance of secondary phases. Lowest loss is obtained for a Zn and Ta completely ordered BZT ceramic with a strongly distorted unit cell. Porosity has small effect on dielectric loss of BZT material.

Well-sintered and annealed BZT samples exhibit a dielectric constant around 31 and a  $Q \times f$  product up to 135 000 GHz. The achieved very-high values of the quality factor  $Q$  recommend the BZT materials for microwave applications.

Different grant than  
the ECERS paper.



**Acknowledgements.** This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEEX No. 4/2005.

## References

- [1] DESU S., O'BRYAN H. M., *Microwave loss quality of Ba(Zn<sub>1/3</sub>Ta<sub>2/3</sub>)O<sub>3</sub> ceramics*, J. Am. Ceram. Soc., vol. **68**, no. 10, pp. 546–551, 1985.
- [2] REANEY I. M. *et al.*, *Ordering and quality factor in 0.95 BaZn<sub>1/3</sub>Ta<sub>2/3</sub>O<sub>3</sub> – 0.05 SrGa<sub>1/2</sub>Ta<sub>1/2</sub>O<sub>3</sub> production resonators*, J. Eur. Ceram. Soc., vol. **23**, no. 16, pp. 3021–3034, 2003.
- [3] SAGALA D. A., NAMBU S., *Microscopic calculation of dielectric loss at microwave frequencies for complex perovskite Ba(Zn<sub>1/3</sub>Ta<sub>2/3</sub>)O<sub>3</sub>*, J. Am. Ceram. Soc., vol. **75**, no. 9, pp. 2573–2575, 1992.
- [4] GALLASSO F., PYLE J., *Ordering of the compounds of the A(B<sub>0.33</sub>Ta<sub>0.66</sub>)O<sub>3</sub> type*, Inorg. Chem., vol. **2**, no. 3, pp. 482–484, 1983.